

IGBT FGH60N60SFD FAIRCHILD

600V, 60A Field Stop IGBT

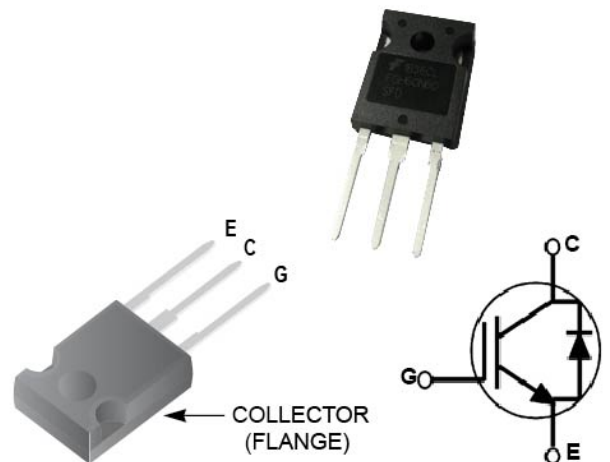
ใช้กับเครื่องเชื่อม STICK 165 IGBT

และใช้ได้กับเครื่องเชื่อมทุกแบบชนิดในระบบเดียวกัน

Features

- High current capability
- Low saturation voltage: $V_{CE(sat)} = 2.3V$
@ $I_C = 60A$
- High input impedance
- Fast switching
- RoHS compliant

300.-



MOSFET K3878 TOSHIBA

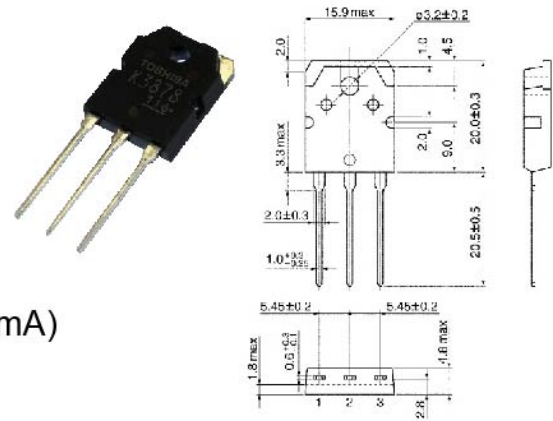
ใช้กับเครื่องเชื่อม TIG, AC/DZ, STICK, CUT

และใช้ได้กับทุกแบบชนิดในระบบเดียวกัน

Features

- Low drain-source ON-resistance: $R_{DS(ON)} = 1.0 \Omega$ (typ.)
- High forward transfer admittance: $|Y_{fs}| = 7.0 S$ (typ.)
- Low leakage current: $I_{DSS} = 100 \mu A$ (max) ($V_{DS} = 720 V$)
- Enhancement model: $V_{th} = 2.0$ to $4.0 V$ ($V_{DS} = 10 V$, $I_D = 1 mA$)

100.-



MOSFET K2837 TOSHIBA

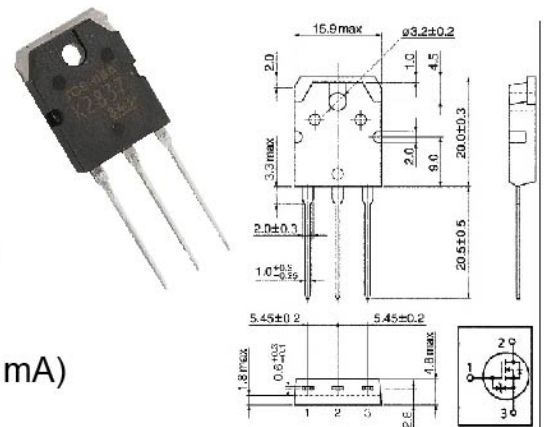
Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications

ใช้กับเครื่องเชื่อม TIG, STICK, CUT และใช้ได้กับทุกแบบชนิดในระบบเดียวกัน

Features

- Low drain-source ON resistance : $R_{DS(ON)} = 0.21 \Omega$ (typ.)
- High forward transfer admittance : $|Y_{fs}| = 17 S$ (typ.)
- Low leakage current : $I_{DSS} = 100 \mu A$ (max) ($V_{DS} = 500 V$)
- Enhancement mode : $V_{th} = 2.0$ to $4.0 V$ ($V_{DS} = 10 V$, $I_D = 1 mA$)

65.-



MOSFET K4107 TOSHIBA

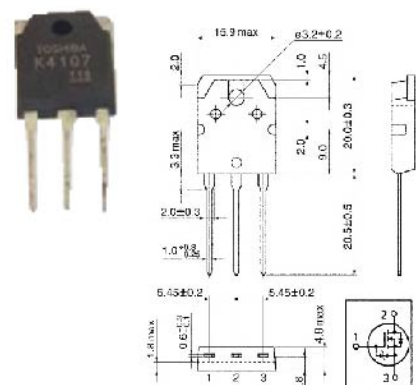
ใช้กับเครื่องเชื่อม TIG, AC, DC, STICK, CUT

และใช้ได้กับทุกแบบชนิดในระบบเดียวกัน

Features

- Low drain-source ON resistance : $R_{DS(ON)} = 0.33 \Omega$ (typ.)
- High forward transfer admittance : $|Y_{fs}| = 8.5 S$ (typ.)
- Low leakage current : $I_{DSS} = 100 \mu A$ (max) ($V_{DS} = 500 V$)
- Enhancement mode : $V_{th} = 2.0$ to $4.0 V$ ($V_{DS} = 10 V$, $I_D = 1 mA$)

125.-



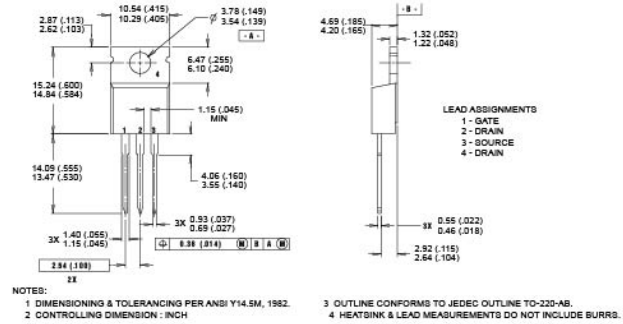
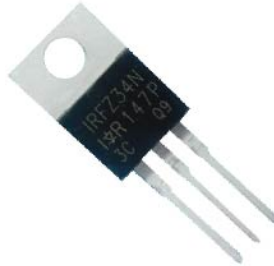
MOSFET IRFZ34N International Rectifier

VDSS = 55V RDS(on) = 0.040Ω ID = 29A

ใช้ได้กับเครื่องเชื่อมทุกรุ่น ทุกแบรนด์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

Features

- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- Dynamic dv/dt Rating
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Ease of Paralleling



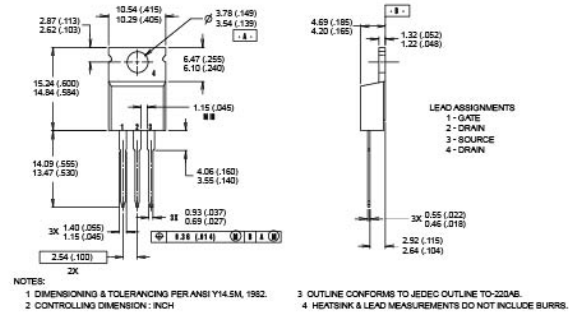
40.-

MOSFET IRF9Z34N International Rectifier

VDSS = -55V / RDS(on) = 0.10 Ω / ID = -19A

ใช้ได้กับเครื่องเชื่อมทุกรุ่น ทุกแบรนด์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

- Advanced Process Technology
- Dynamic dv/dt Rating
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- P-Channel
- Fully Avalanche Rated



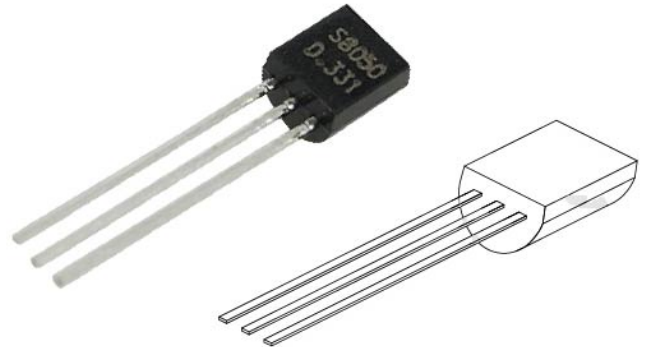
45.-

TRANSISTOR S8050

ใช้ได้กับเครื่องเชื่อมทุกรุ่น ทุกแบรนด์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

Features

- Collector current up to 700mA
- Collector-Emitter voltage up to 20 V
- Complementary to S8550



10.-

ชิป IGBT

Chip IGBT FGH60N60SMD

FAIRCHILD 60A

สำหรับ เครื่องเชื่อม Stick 165

Chip IGBT FGH40N60SFD

FAIRCHILD 40A

สำหรับ เครื่องเชื่อม Boxing 300

Chip IGBT G60N100

FAIRCHILD



450.-

MOSFET FSA24N50

ใช้แทน FEP23N50E, K2837, FSA20N50E

ทำหน้าที่ ควบคุมปริมาณของสนามไฟฟ้า

ระหว่างรอยต่อให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง

สามารถใช้กับเครื่องเชื่อม

Boxing 200

Stick 200

TIG & Stick 200

TIG 200

Cut 40

100.-



บรรจุ 30 ตัว/กล่อง

MOSFET 6N90C FAIRCHILD

สำหรับ

เครื่องเชื่อม

»TIG200A

»STICK 200

เครื่องตัดพลาสมา

»CUT 40

80.-



MOSFET IRFZ24N International Rectifier

สำหรับ

เครื่องเชื่อม

»TIG200A

»STICK 200

เครื่องตัดพลาสมา

»CUT 40

20.-



MOSFET IRF9Z24N International Rectifier

สำหรับ

เครื่องเชื่อม

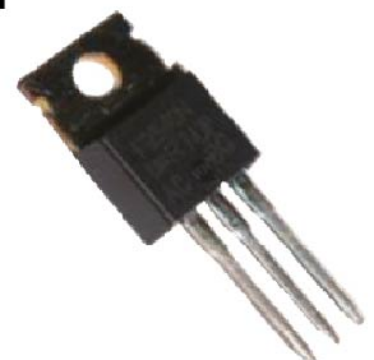
»TIG200A

»STICK 200

เครื่องตัดพลาสมา

»CUT 40

25.-

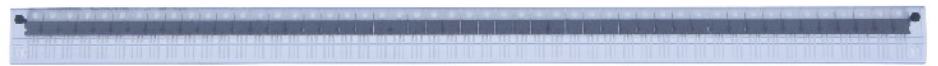
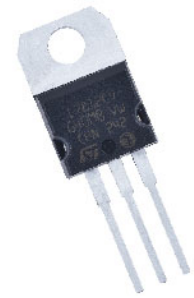


ไอซี IC

ทำหน้าที่ เป็นตัวแปลงไฟ
สามารถใช้กับเครื่องเชื่อม

- Boxing 200
- Stick 200
- TIG & Stick 200
- TIG 200
- Cut 40, 60

10.-



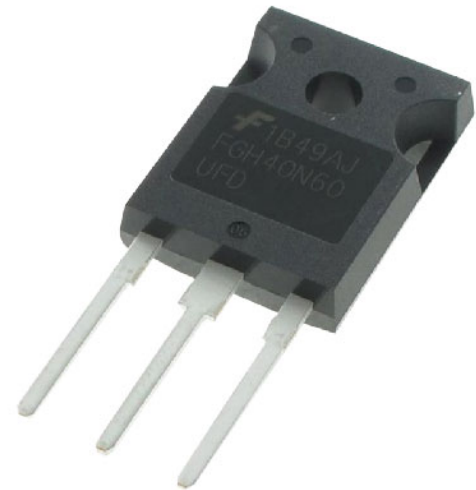
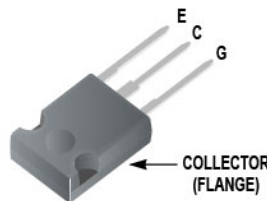
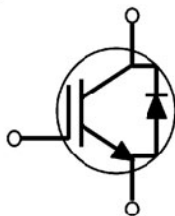
บรรจุ 50 ตัว/กล่อง

IGBT FGH40N60SFD FAIRCHILD

ใช้กับเครื่องเชื่อม Boxing 300 และใช้ได้กับเครื่องเชื่อมทุกแบรนด์ในระบบเดียวกัน
600V, 40A Field Stop IGBT

Features

- High current capability
- Low saturation voltage: $V_{CE(sat)} = 2.3V @ I_C = 60A$
- High input impedance
- Fast switching
- RoHS compliant



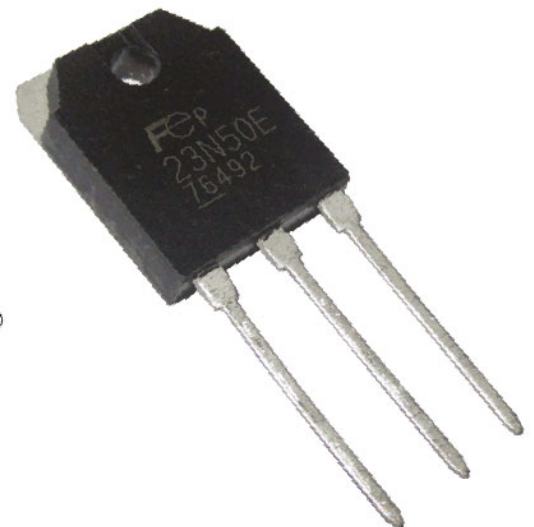
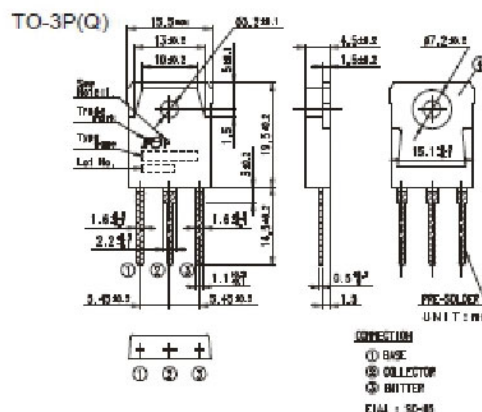
150.-

MOSFET 23N50E

ใช้กับเครื่องเชื่อม TIG/STICK 300, STICK 300
เครื่องตัดพลาสมา CUT 40
และเครื่องเชื่อมแบรนด์อื่นที่ระบบวงจรคล้ายกัน

Feature

- Maintains both low power loss and low noise
- Lower $R_{DS(on)}$ characteristic
- More controllable switching dv/dt by gate resistance
- Smaller VGS ringing waveform during switching
- Narrow band of the gate threshold voltage ($3.0 \pm 0.5V$)
- High avalanche durability



80.-